



BZG04 Series

Transient Voltage Suppressor

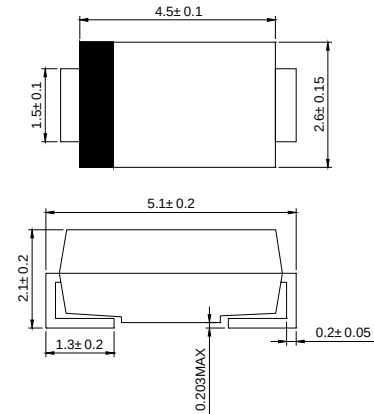
BREAKDOWN VOLTAGE: 8.2 --- 220 V

PEAK PULSE POWER: 300 W

Features

- ◇ Plastic package has underwriters laboratory flammability classification 94V-0
- ◇ Optimized for LAN protection applications
- ◇ Low profile package with built-in strain relief for surface mounted applications
- ◇ Glass passivated junction
- ◇ Low incremental surge resistance, excellent clamping capability
- ◇ 300W peak pulse power capability with a 10/1000 μ s waveform, repetition rate (duty cycle): 0.01%
- ◇ Very fast response time
- ◇ High temperature soldering guaranteed: 250°C/10 seconds at terminals

DO-214AC(SMA)



Dimensions in millimeters

Mechanical Data

- ◇ Case: JEDEC DO-214AC molded plastic over passivated chip
- ◇ Terminals: solder plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026
- ◇ Mounting position: any Weight: 0.002 ounces, 0.064 grams

Devices for Bidirectional Applications

For bi-directional devices, use suffix C (e.g. BZG04-10C). Electrical characteristics apply in both directions.

MAXIMUM RATINGS AND CHARACTERISTICS

Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified.

	SYMBOL	VALUE	UNIT
Non-repetitive peak reverse power dissipation 10/1000s exponential pulse(see Fig.3); T _J =25°C prior to surge; see also Fig.1	P _{RSM}	300	W
Typical thermal resistance, junction to ambient	R _{θJA}	100(NOTE1) 150(NOTE2)	°C/W
Forward voltage @I _F =0.5A; see Fig.2	V _F	1.2	V
Operating junction temperature range	R _{θJL}	-55---+175	°C
Operating storage temperature range	T _J	-55---+175	°C

NOTES: (1) Device mounted on an Al₂O₃ printed-circuit board, 0.7mm thick; thickness of Cu-layer $\geq$ 35 μ m, see Fig.4.

(2) Device mounted on an epoxy-glass printed-circuit board, 1.5mm thick; thickness of Cu-layer $\geq$ 40 μ m, see Fig.4.

For more information please refer to the "General Part of associated Handbook".

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

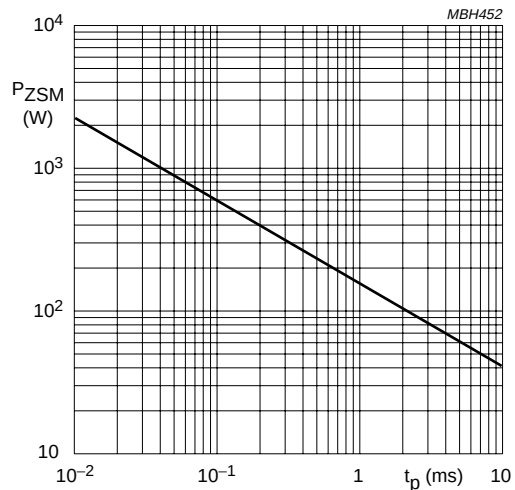
Ratings at 25°C ambient temperature unless otherwise specified. (uni-directional only)

Partnumber	Reverse breakdown voltage	Temperature coefficient		Test current	Clamping voltage		Reverse current at reverse voltage	
	$V_{(BR)R}$ at I_{test}	$\alpha_z @ I_z$		I_{ZT}	$V_{(CL)R}$	at I_{RSM}	I_R	V_R
	V	% / °C		m A	V	(note 1)	μA	V
	MIN.	MIN.	MAX.		MAX.	A	MAX.	
BZG04-8V2	9.4	0.05	0.09	50	14.8	20.3	20	8.2
BZG04-9V1	10.4	0.05	0.10	50	15.7	19.1	5	9.1
BZG04-10	11.4	0.05	0.10	50	17	17.7	5	10
BZG04-11	12.4	0.05	0.10	50	18.9	15.9	5	11
BZG04-12	13.8	0.05	0.10	50	20.9	14.4	5	12
BZG04-13	15.3	0.06	0.11	25	22.9	13.1	5	13
BZG04-15	16.8	0.06	0.11	25	25.6	11.7	5	15
BZG04-16	18.8	0.06	0.11	25	28.4	10.6	5	16
BZG04-18	20.8	0.06	0.11	25	31.0	9.7	5	18
BZG04-20	22.8	0.06	0.11	25	33.8	8.9	5	20
BZG04-22	25.1	0.06	0.11	25	38.1	7.9	5	22
BZG04-24	28	0.06	0.11	25	42.2	7.1	5	24
BZG04-27	31	0.06	0.11	25	46.2	6.5	5	27
BZG04-30	34	0.06	0.11	10	50.1	6.0	5	30
BZG04-33	37	0.06	0.11	10	54.1	5.5	5	33
BZG04-36	40	0.07	0.12	10	60.7	4.9	5	36
BZG04-39	44	0.07	0.12	10	65.5	4.6	5	39
BZG04-43	48	0.07	0.12	10	70.8	4.2	5	43
BZG04-47	52	0.07	0.12	10	78.6	3.8	5	47
BZG04-51	58	0.08	0.13	10	86.5	3.5	5	51
BZG04-56	64	0.08	0.13	10	94.4	3.2	5	56
BZG04-62	70	0.08	0.13	10	103.5	2.9	5	62
BZG04-68	77	0.08	0.13	10	114	2.6	5	68
BZG04-75	85	0.09	0.13	5.0	126	2.4	5	75
BZG04-82	94	0.09	0.13	5.0	139	2.2	5	82
BZG04-91	104	0.09	0.13	5.0	152	2.0	5	91
BZG04-100	114	0.09	0.13	5.0	167	1.8	5	100
BZG04-110	124	0.09	0.13	5.0	185	1.6	5	110
BZG04-120	138	0.09	0.13	5.0	204	1.5	5	120
BZG04-130	153	0.09	0.13	5.0	224	1.3	5	130
BZG04-150	168	0.09	0.13	5.0	249	1.2	5	150
BZG04-160	188	0.09	0.13	5.0	276	1.1	5	160
BZG04-180	208	0.09	0.13	2.0	305	1.0	5	180
BZG04-200	228	0.09	0.13	2.0	336	0.9	5	200
BZG04-220	251	0.09	0.13	2.0	380	0.8	5	220

NOTES: 1. Non-repetitive peak reverse current in accordance with "IEC60-1, Section8" (10/1000s pulse); see Fig.3.

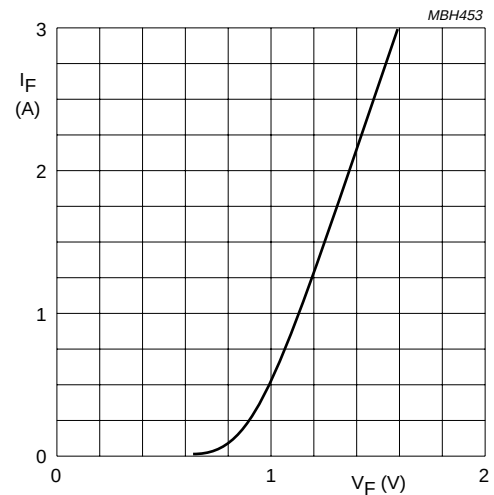
Ratings AND Characteristic Curves

Fig.1 Maximum non-repetitive peak reverse power dissipation as a function of pulse duration (square pulse).



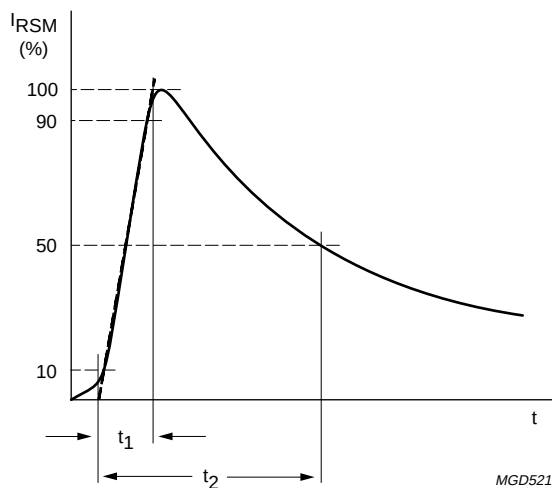
$T_j = 25^\circ\text{C}$ prior to surge.

Fig.2 Forward current as a function of forward voltage; typical values.



$T_j = 25^\circ\text{C}$.

Fig.3 Non-repetitive peak reverse current pulse definition.

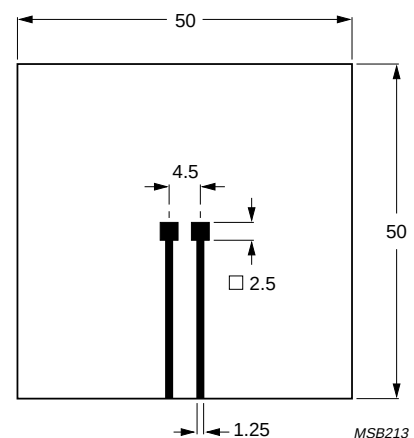


In accordance with "IEC 60-1, Section 8".

$t_1 = 10\ \mu\text{s}$.

$t_2 = 1000\ \mu\text{s}$.

Fig.4 Printed-circuit board for surface mounting.



Dimensions in mm.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.